

Revendicări:

Procedeu de obținere a structurii multistrat prin evaporarea termică în vid pe suport rigid sau flexibil de diferite după compoziție straturi de semiconductori chalcogenici sticloși cu diferiți indici de refracție, **caracterizat prin aceea că** straturile se obțin din As_2S_3 schimbându-i temperatura de evaporare de la 120 până la 280°C.

Revendicările se bazează în întregime pe descrierea invenției la certificatul de autor nr. 1674496, SU.